

# МП114

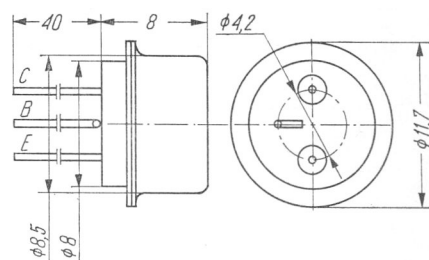
**Typ tranzystora:** tranzystor krzemowy

**Firma:** ZSRR

**Wykonanie:** tranzystor krzemowy stopowy *p-n-p* małej mocy m.cz., w hermetycznej obudowie metalowej

**Zastosowanie:** układy wzmacniające i generacyjne w urządzeniach powszechnego użytku

**Typy podobne:** OC200 ÷ 202



Rys. 1-1413. МП114

## Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>

|            |     |          |                                                       |
|------------|-----|----------|-------------------------------------------------------|
| $I_{CB0}$  | 10  | $\mu A$  | przy $U_C = 30 V$                                     |
| $I_{EB0}$  | 10  | $\mu A$  | przy $U_E = 10 V$                                     |
| $U_{CER}$  | 60  | V        | przy $R_{BE} = 2 k\Omega$ , $t_{amb} \leq 75^\circ C$ |
| $h_{11b}$  | 300 | $\Omega$ | przy $I_E = 1 mA$ , $U_C = 50 V$ , $f = 1 kHz$        |
| $h_{21e}$  | 9   |          | przy $U_C = 5 V$ , $I_E = 1 mA$ , $f = 1 kHz$         |
| $f_{h21b}$ | 0,1 | MHz      | przy $U_C = 5 V$ , $I_E = 1 mA$                       |

## Wartości graniczne

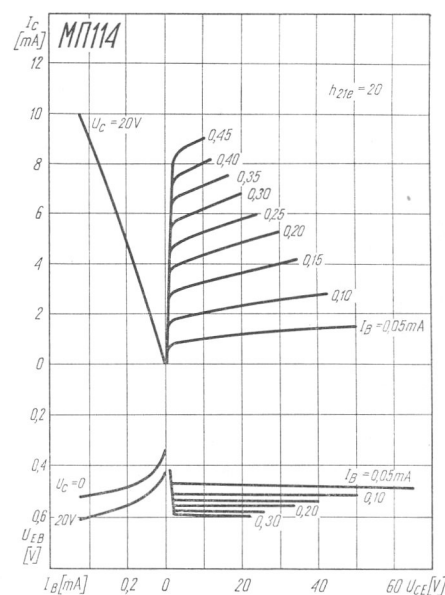
|               |                  |    |               |                   |            |
|---------------|------------------|----|---------------|-------------------|------------|
| $U_{CER max}$ | 60 <sup>2)</sup> | V  | $I_{CM max}$  | 50                | mA         |
| $U_{CER max}$ | 30 <sup>3)</sup> | V  | $P_{tot max}$ | 150 <sup>4)</sup> | mW         |
| $U_{EB0 max}$ | 10               | V  | $t_j max$     | 120               | $^\circ C$ |
| $I_C max$     | 10               | mA | $t_{amb}$     | $-55 \div +100$   | $^\circ C$ |

<sup>1)</sup>  $t_{amb} = 20^\circ C (\pm 5^\circ)$

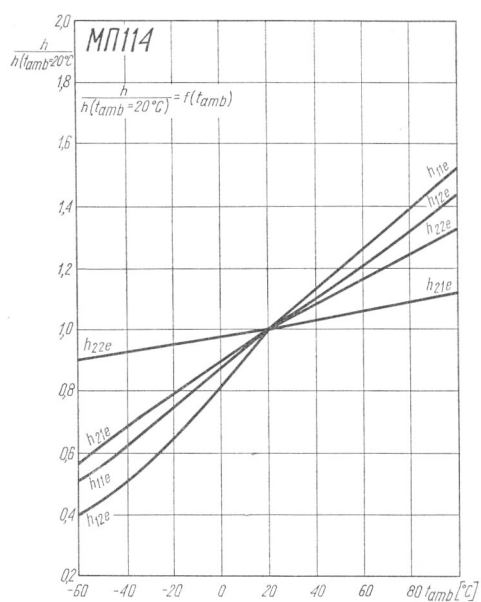
<sup>2)</sup>  $R_{BE} = 2 k\Omega$ ,  $t_{amb} < 70^\circ C$

<sup>3)</sup>  $R_{BE} = 2 k\Omega$ ,  $t_{amb} > 70^\circ C$

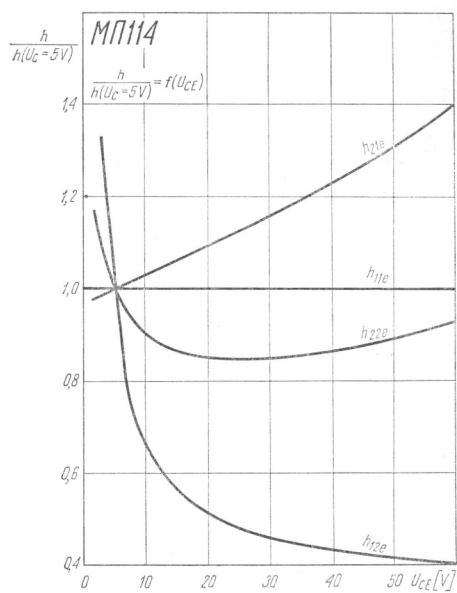
<sup>4)</sup>  $t_{amb} \leq 70^\circ C$



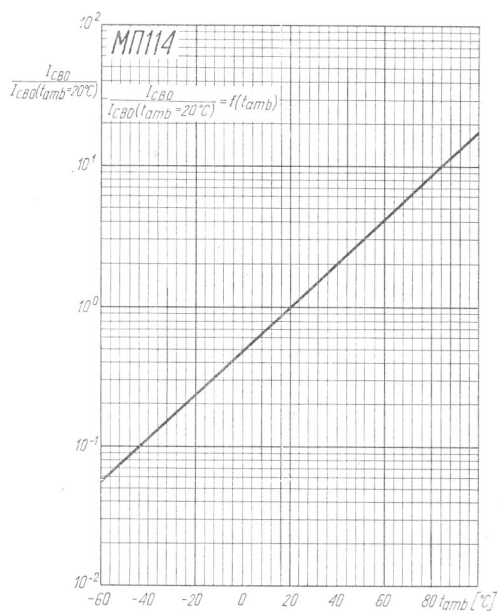
Rys. 1-1414. Charakterystyki statyczne



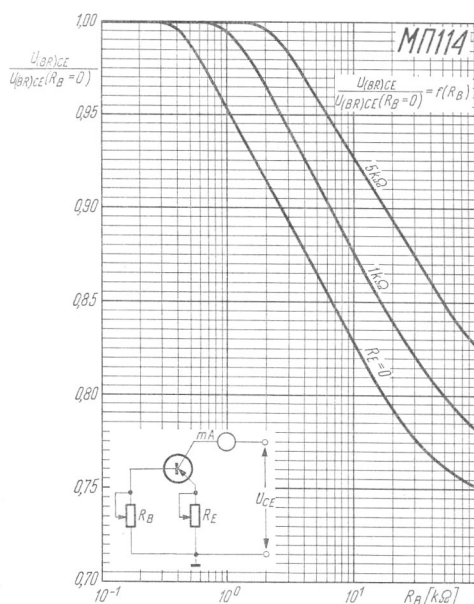
Rys. 1-1415. Zależność parametrów  $h$  od temperatury otoczenia



Rys. 1-1416. Zależność parametrów  $h$  od napięcia kolektora



Rys. 1-1417. Zależność znormalizowanego prądu zerowego kolektora od temperatury otoczenia



Rys. 1-1418. Zależność znormalizowanego napięcia przebicia kolektora od rezystancji bazy